



Registerauszug zum Aktenzeichen 100 61 310.1

Stand am 18.05.2024
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 26.01.2016)

Es bestehen folgende Eintragungen:

Stammdaten

- [-----] **Schutzrechtsart:** Patent
- [-----] **Status:** Nicht anhängig/erloschen
- [21] **Aktenzeichen DE:** 100 61 310.1
- [54] **Bezeichnung/Titel:** Halbleiterbauelement mit erhöhter Durchbruchspannung sowie dazugehöriges Herstellungsverfahren
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 29/06 (2000.01)
- [51] **IPC-Nebeklasse(n):** H01L 29/78 (2000.01);H01L 29/739 (2000.01)
- [22] **Anmeldetag DE:** 08.12.2000
- [43] **Offenlegungstag:** 27.06.2002
- [71/
73] **Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, 81669 München, DE
- [-----] **Erfinder:** Weber, Hans, Dr., 83404 Ainring, DE; Ahlers, Dirk, Dr., 80796 München, DE; Stengl, Jens-Peer, 82284 Grafrath, DE; Deboy, Gerald, Dr., 80538 München, DE; Willmeroth, Armin, 86163 Augsburg, DE; Rüb, Michael, Dr., Faak, AT; Marion, Miguel Cuadron, 81543 München, DE;
- [74] **Vertreter:** Kindermann, Peter, Dipl.-Ing.Univ., 85598 Baldham, DE
- [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000010061310A1
- [-----] **Zustellanschrift:** Kindermann, Peter, Dipl.-Ing.Univ., 85598 Baldham, DE
- [-----] **Zuständige Patentabteilung:** 33
- [57] **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit erhöhter Durchbruchspannung mit einer aktiven Struktur (AS) und einer Randstruktur (RS). Eine Vielzahl von ersten und zweiten Rand-Kompensationsgebieten (2 und 3) sind hierbei derart in der Randstruktur ausgebildet, dass die zweiten Rand-Kompensationsgebiete (3) vollständig von Ladungsträgern ausgeräumt werden und eine

Kompensationsfeldstärke in der Randstruktur (RS) geringer ist als eine Kompensationsfeldstärke in einer aktiven Struktur (AS) des Halbleiterbauelements.

- [56] **Entgegenhaltungen/Zitate:** EP000001011146A1 (EP 10 11 146 A1)
- [43] **Erstveröffentlichungstag:** 27.06.2002
- [-----] **Anzahl der Bescheide:** 1
- [-----] **Anzahl der Erwiderungen:** 1
- [-----] **Erstmalige Übernahme in DPMAreger:** 27.05.2011
- [-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMAreger:** 27.05.2011; 10.02.2013; 26.01.2016

Verfahrensdaten

Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 08.12.2000

Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsantrag wirksam gestellt
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 08.12.2000
- [-----] **Antrag Dritter:** Nein
- [-----] **Eingangstag:** 08.12.2000

Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Das Vorverfahren ist abgeschlossen
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 29.03.2001

Klassifikationsänderung

- [-----] **Verfahrensart:** Klassifikationsänderung
- [-----] **Verfahrensstand:** Änderung der IPC-Hauptklasse
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 04.04.2001
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 29/06 (2000.01)
- [51] **Frühere IPC-Hauptklasse:** H01L 29/00 (2000.01)

Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Erwidern auf Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 19.12.2001

Publikationen

- [-----] **Verfahrensart:** Publikationen

[-----] **Verfahrensstand:** Offenlegungsschrift
[-----] **Verfahrensstandstag:** 27.06.2002
[-----] **Heftnummer:** 26
[-----] **Jahr:** 2002
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 27.06.2002
[-----] **Publikationsart:** Schriften
[-----] **Teil:** Teil 1
[10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE000010061310A1

Verwaltungsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Verwaltungsverfahren
[-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung gilt als zurückgenommen wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr/das Schutzrecht ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen
[-----] **Verfahrensstandstag:** 01.07.2003
[-----] **Heftnummer:** 41
[-----] **Jahr:** 2003
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 09.10.2003
[-----] **Publikationsart:** Bibliografiedaten
[-----] **Teil:** Teil 1